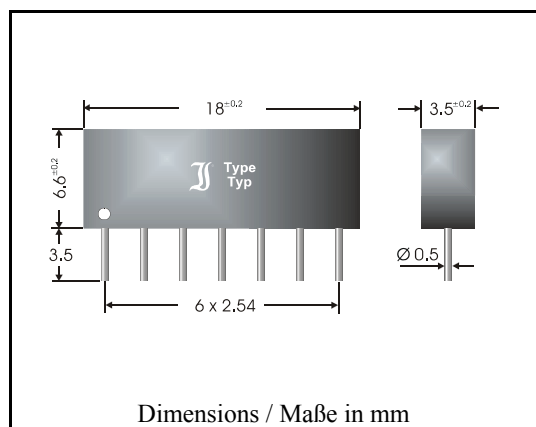
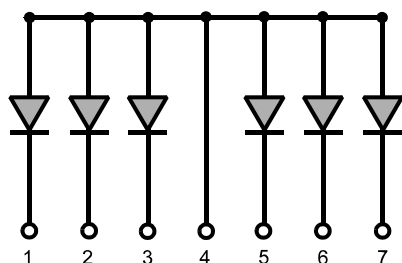
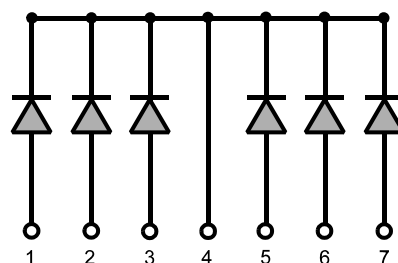


Small Signal Diode Arrays
Dioden Sätze mit Allzweckdioden


Nominal power dissipation	200 mW
Nenn-Verlustleistung	
Repetitive peak reverse voltage	80 V
Periodische Spitzensperrspannung	
7 Pin-Plastic case	18 x 3.5 x 6.6 [mm]
7 Pin-Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 601	80	80
DAP 601	80	80

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV}	100 mA ¹⁾
I_{FAV}	33 mA ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschialtung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV}	100 mA ¹⁾
I_{FAV}	33 mA ¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FSM}	500 mA
-----------	--------

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{ mA}$	V_F	$< 1.0\text{ V}^1)$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20\text{ V}$	I_R	$< 25\text{ nA}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$		t_{rr}	$< 4\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 85\text{ K/W}^2)$

¹⁾ Valid per diode – Gültig pro Diode

²⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten